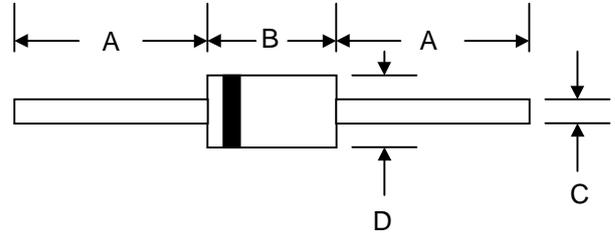


主要电气参数

$I_{F(AV)}$	2.0 A
V_{RRM}	50 - 1000V
I_{FSM}	70 A
I_R	5uA
V_F	1.1V
$T_{j\ max}$	150°C

封装尺寸规格:



特性:

- 符合 UL94 V-0 标准
- 低正向压降
- 低反向漏电
- 耐高瞬间正向浪涌电流冲击
- 符合 RoHS 2002/95/1 指令要求
- 高性能 PN 结硅整流芯片



DO-15		
Dim	Min	Max
A	25.4	—
B	5.50	7.62
C	0.71	0.864
D	2.60	3.60
All Dimensions in mm		

外观参数:

- 封装: 符合 JEDEC DO-15 封装标准, 高性能 PN 结芯片结合外部轴向塑封
- 引脚: 表面镀锡, 可焊性参照 J-STD-002B 和 JESD22-B102D
- 极性标示: 激光打印, 阴极标有阴极线条

额定参数表: 如无特殊说明, 参考温度均为 $T_c = 25^\circ\text{C}$

电气参数	符号	RL201	RL202	RL203	RL204	RL205	RL206	RL207	单位
交流最高反向峰值电压	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
交流最高反向电压有效值	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	Volts
直流最高反向截止电压	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
最大平均正向整流电流@75°C	I_F	2.0							Amps
交流单相, 半波8.3ms正向浪涌电流, 负载参考上述负载	I_{FSM}	70.0							Amps
最高正向电压@1.0A直流电流	V_F	1.1							Volts
最高直流反向漏电流@直流最高反向截止电压	25°C	5.0							uAmps
	125°C	50.0							uAmps
结电容(注)	C_j	15							pF
工作结温和储存温度范围	T_J, T_{STG}	-55 to 150							°C
注: 结电容在1MHz频率下外加4V电压测试									

FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE

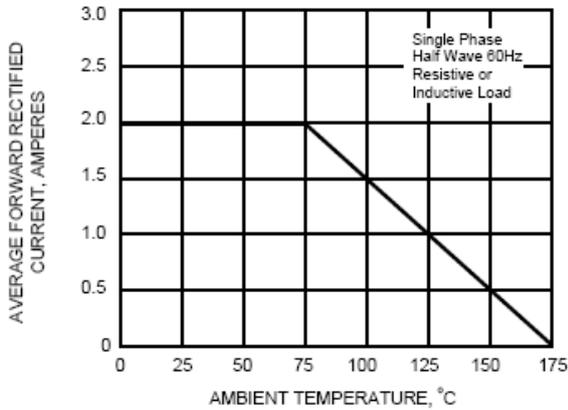


FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

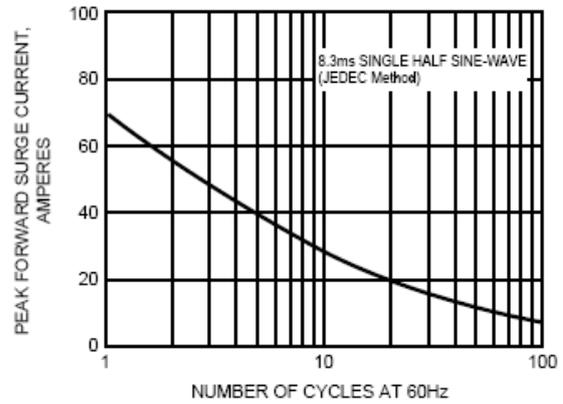


FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

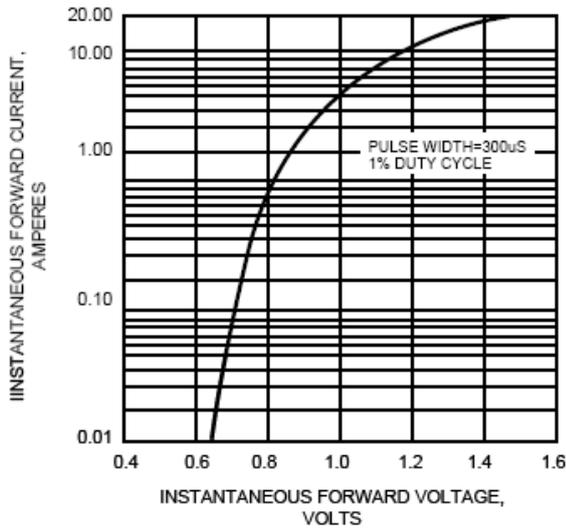


FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

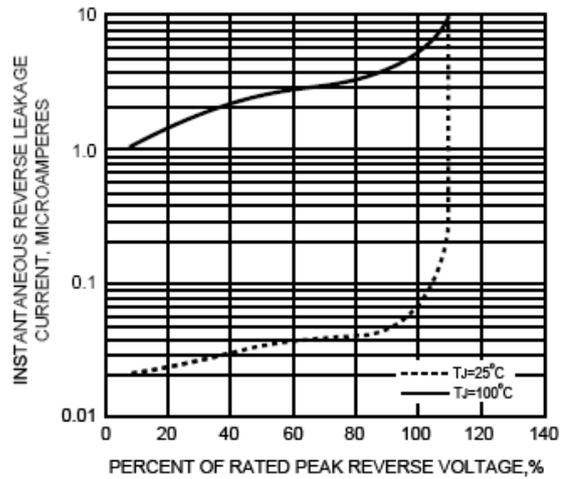


FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

